

Содержание

- XV Международная конференция „Термоэлектрики и их применения — 2016“ Санкт-Петербург, 15–16 ноября 2016 г.

Бурков А.Т., Новиков С.В., Зайцев В.К., Рейсс Х.

Низкотемпературный транспорт в моносилициде кобальта и сплавах на его основе 723

Лукьянова Л.Н., Бойков Ю.А., Усов О.А., Данилов В.А.

Эффективная масса плотности состояний и подвижность носителей заряда в гетероэпитаксиальных пленках теллурида висмута и твердых растворах $\text{Bi}_{0,5}\text{Sb}_{1,5}\text{Te}_3$ 726

Булат Л.П., Пшеная-Северин Д.А., Освенский В.Б., Пархоменко Ю.Н.

Расчет теплопроводности наноструктурированного Bi_2Te_3 с учетом реального фононного спектра 729

Урюпин О.Н., Шабалдин А.А.

Термоэлектрические свойства $\text{InSb}(\text{Zn})$ в нанопористом стекле 733

Комаров В.А., Суслов А.В., Суслов М.В.

Гальваномагнитные свойства тонких пленок $\text{Bi}_{85}\text{Sb}_{15}$ на различных подложках 736

Орехов А.С., Камиллов Т.С., Ибрагимова Б.В., Ивакин Г.И., Клечковская В.В.

Структура термоэлектрических пленок высшего силицида марганца на кремнии по данным электронной микроскопии 740

Япрынцев М.Н., Любушкин Р.А., Соклакова О.Н., Иванов О.Н.

Синтез и электрофизические свойства термоэлектрического материала на основе Bi_2Te_3 , легированного лантаноидами Er, Tm, Yb и Lu 744

Панченко В.П., Табачкова Н.Ю., Иванов А.А., Сенатулин Б.Р., Андреев Е.А.

Получение и свойства термоэлектрического материала на основе Zn_4Sb_3 748

Ховайло В.В., Воронин А.И., Зуева В.Ю., Середина М.А., Чаттерджи Р.

Полупроводниковые сплавы Гейслера на основе Fe 752

Булат Л.П., Новотельнова А.В., Освенский В.Б., Тукмакова А.С., Ережеп Д.

Моделирование активированного электрическим полем спекания термоэлектриков 756

Яковлева Г.Е., Романенко А.И., Бердинский А.С., Кузнецов В.А., Леднева А.Ю., Артемкина С.Б., Федоров В.Е.

Влияние катионного и анионного замещения в дисульфиде и диселениде вольфрама на электропроводность и термоэдс 759

Лукьянова Л.Н., Бибики А.Ю., Асеев В.А., Усов О.А., Макаренко И.В., Петров В.Н., Никоноров Н.В.

Морфология межслоевой поверхности и микро-рамановские спектры в слоистых пленках топологических изоляторов на основе теллурида висмута 763

• Неэлектрошные свойства полупроводников (атомная структура, диффузия)

Алыев Ю.И., Асадов Ю.Г., Алыева Р.Д., Джабаров С.Г.

Полиморфные превращения и термическое расширение кристаллов $\text{AgCuSe}_{0,5}(\text{S,Te})_{0,5}$ 766

Алексеев И.В., Горемычкин Е.А., Гундорин Н.А., Петренко А.В., Сашин И.Л.

Детектор нейтронов на основе кристаллов TlInSe_2 , интеркалированных изотопом лития 773

Кожемяко А.В., Балакшин Ю.В., Шемухин А.А., Черныш В.С.

Изучение профиля распределения железа, имплантированного в кремний 778

• Электрошные свойства полупроводников

Ницук Ю.А., Ваксман Ю.Ф.

Электрофизические свойства кристаллов ZnSe , легированных переходными элементами 783

Рехвиашвили С.Ш., Алиханов А.А.

Моделирование диффузионно-дрейфового транспорта носителей заряда в полупроводниковых слоях с фрактальной структурой в переменном электрическом поле 787

Галиев Г.Б., Клочков А.Н., Васильевский И.С., Климов Е.А., Пушкарев С.С., Виниченко А.Н., Хабибуллин Р.А., Мальцев П.П.

Электронные свойства приповерхностных квантовых ям $\text{InGaAs}/\text{InAlAs}$ с инвертированным легированием на подложках InP 792

• Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления

Алексеев П.С., Горный И.В., Дмитриев А.П., Качоровский В.Ю., Семина М.А.

Классическое магнетосопротивление двухкомпонентной системы, обусловленное термоэлектрическими эффектами 798

● **Аморфные, стеклообразные, органические полупроводники**

Мехтиева С.И., Атаева С.У., Исаев А.И., Зейналов В.З.

Влияние примеси самария на структуру и морфологию поверхности халькогенидного стеклообразного полупроводника $\text{Sc}_{0.5}\text{Te}_5$ 809

● **Микро- и нанокристаллические, пористые, композитные полупроводники**

Басалаев Ю.М., Копытов А.В., Поплавной А.С., Польшгалов Ю.И.

Первопринципное исследование электронного и колебательного стросний тетрагонального диарсеннида кадмия . 815

● **Физика полупроводниковых приборов**

Клочко Н.П., Копач В.Р., Хрипунов Г.С., Корсун В.Е., Волкова Н.Д., Любов В.Н., Кириченко М.В., Копач А.В., Жадан Д.О., Отченашко А.Н.

Барьерная гетероструктура $n\text{-ZnO}/p\text{-CuI}$ на основе электроосажденных в импульсном режиме наномассивов оксида цинка и изготовленных методом SILAR пленок иодида меди 821

Мнацаканов Т.Т., Левинштейн М.Е., Шуман В.Б., Середин Б.М.

О пределе инжектирующей способности кремниевых $p^+ - n$ -переходов, обусловленном влиянием фундаментальных физических эффектов 830

Горбатюк А.В., Иванов Б.В.

Имитационное моделирование реверсивно-включасмых диодисторов в режимах со сниженным порогом первичного запуска 835

● **Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур**

Бучин Э.Ю., Наумов В.В., Васильев С.В.

Влияние постоянного магнитного поля на формирование силицидных фаз в структуре $\text{Cu}/\text{Si}(100)$ при изотермическом отжиге 844

Кобзиев В.Ф., Закирова Р.М., Костенков Н.В., Крылов П.Н., Федотова И.В.

Влияние температуры осаждения на структуру и оптические свойства пленок селенида цинка, полученных ВЧ магнетронным распылением 850

Кириенко Д.А., Березина О.Я.

Отделение тонких пленок ГТО от кремниевой подложки с помощью микросекундного лазерного облучения 855

Аннотации статей, поступивших в Редакцию журнала на английском языке. Полные тексты этих статей опубликованы в переводной версии журнала „Физика и техника полупроводников“ — SEMICONDUCTORS

Kaminskii V.V., Solov'ev S.M., Khavrov G.D., Sharenkova N.V., Hirai Shinji

Structural Features of $\text{Sm}_{1-x}\text{Eu}_x\text{S}$ Thin Polycrystalline Films 860